



(19)  
Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 100 32 213 B8** 2009.02.12

(12)

## Berichtigung der Patentschrift

(21) Aktenzeichen: **100 32 213.1**

(22) Anmeldetag: **03.07.2000**

(43) Offenlegungstag: **31.05.2001**

(45) Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: **09.10.2008**

(15) Korrekturinformation:  
**Berichtigung zu INID-Code (72)**

(48) Veröffentlichungstag der Berichtigung: **12.02.2009**

(51) Int Cl.<sup>8</sup>: **H01L 21/8242** (2006.01)  
**H01L 27/108** (2006.01)

(30) Unionspriorität:

<b>99-26510</b>	<b>02.07.1999</b>	<b>KR</b>
<b>99-49503</b>	<b>09.11.1999</b>	<b>KR</b>

(73) Patentinhaber:

**Hyundai Electronics Industries Co., Ltd.,  
Kyoungki-do, KR**

(74) Vertreter:

**Schwabe, Sandmair, Marx, 81677 München**

(72) Erfinder:

**Joo, Kwang Chul, Ichon, KR; Lee, Kee Jeung,  
Seoul, KR; Han, Il Keoun, Ichon, KR**

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:

**DE 198 25 736 A1**

**US 59 10 880 A**

**US 57 86 248 A**

**US 54 38 012 A**

**US 53 62 632 A**

**EP 08 74 393 A2**

(54) Bezeichnung: **Verfahren zur Herstellung eines Kondensators für ein Halbleiterspeicherbauelement**

Die oben angegebenen bibliographischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Berichtigung. Die Zusammenfassung bzw. der Hauptanspruch sowie die Titelseitenzeichnung werden aus technischen Gründen hier nicht erneut veröffentlicht. Diese Informationen können der Originalveröffentlichung entnommen werden.